

**Рис. 2-1.** Схема испарителя для напыления пленок многокомпонентных ХСП.

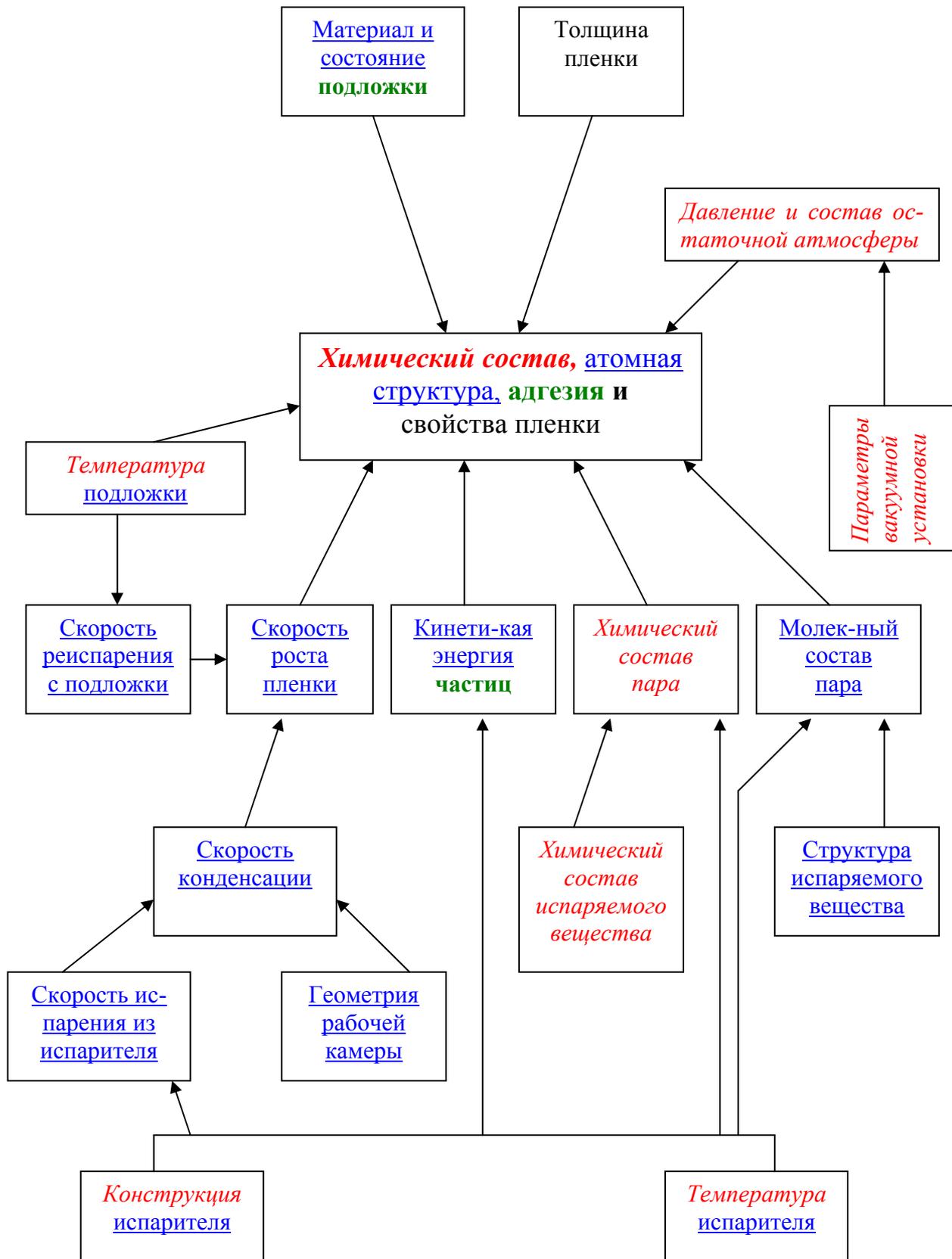
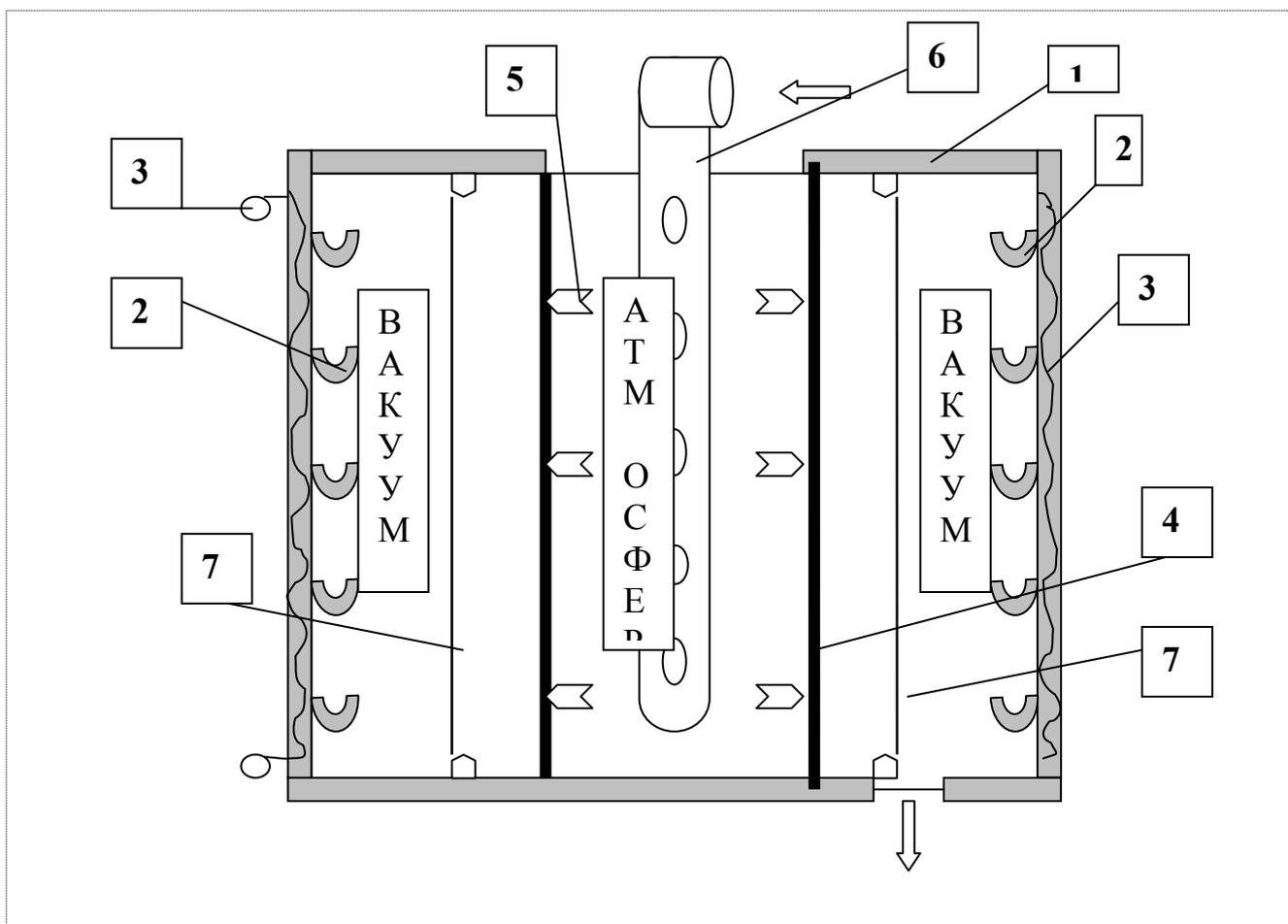
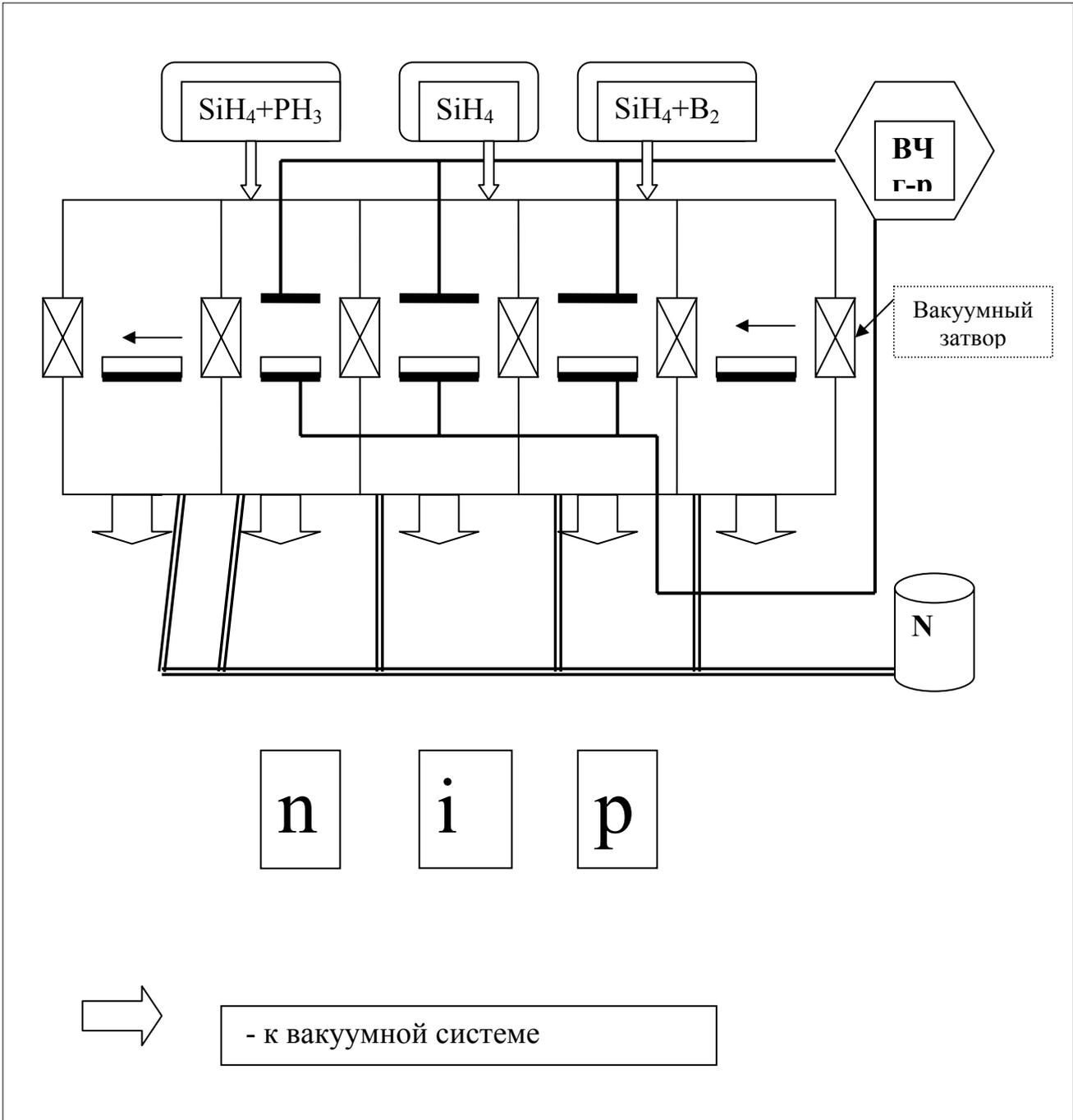


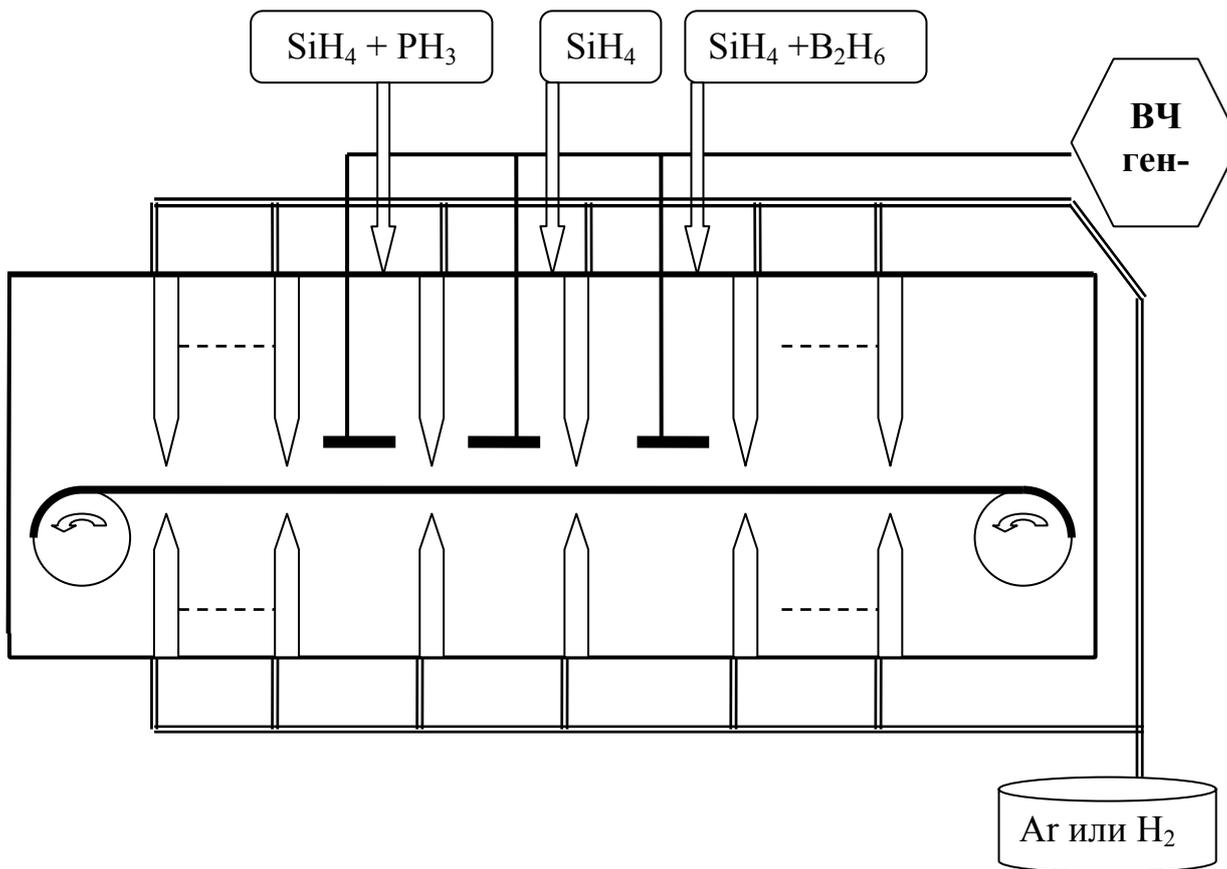
Рис. 2-2. Факторы, определяющие параметры пленок при вакуумном напылении.



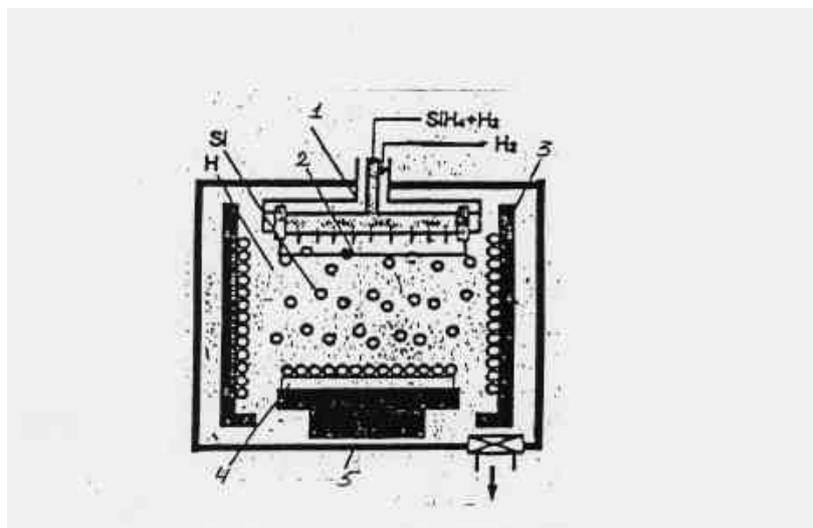
**Рис. 2-3.** Вакуумная установка для получения электрофотографических цилиндров.



**Рис. 2-4.** Установка полунепрерывного действия для получения приборов на основе a-Si:H методом разложения силана в плазме тлеющего разряда (Санья).



**Рис. 2-5.** Установка непрерывного действия для получения фотоэлектрических преобразователей на основе a-Si:H методом разложения силана в плазме тлеющего разряда (фирма ECD).



**Рис. 2-6.** Схема установки для получения пленок a-Si:H CVD-методом.

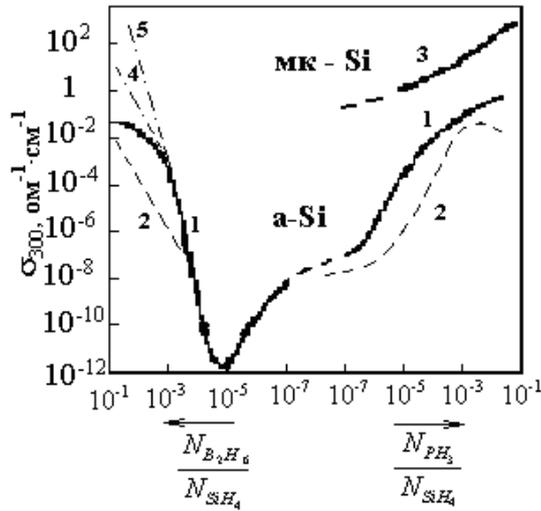


Рис.2-7. Электропроводность микрокристаллического гидрогенизированного кремния.

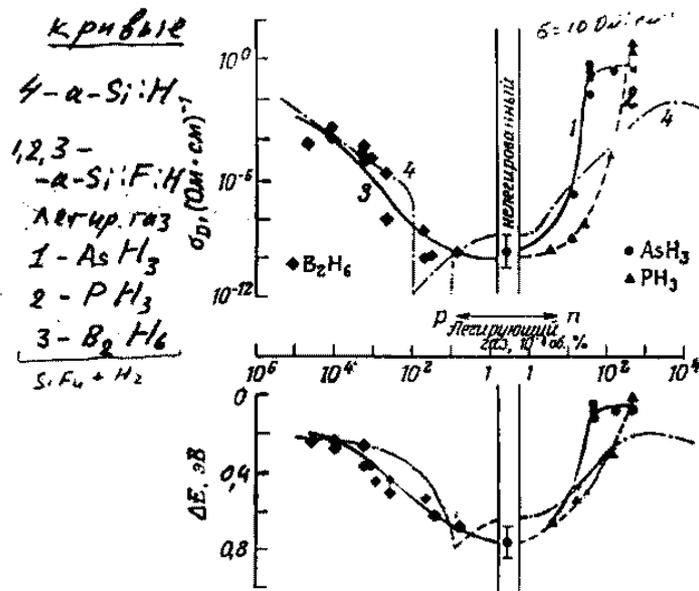


Рис.2-8. Электропроводность фторированного аморфного кремния.

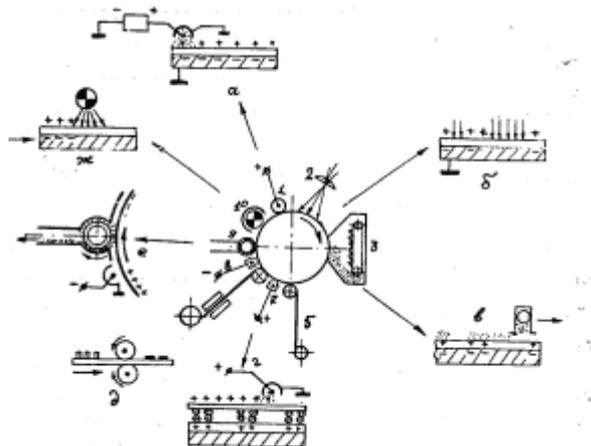


Рис. 2-10. Схема электрофотографического процесса.

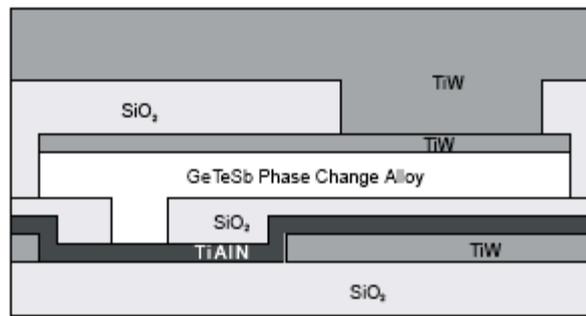


Рис. 2-11. Структура элемента памяти на фазовых переходах.

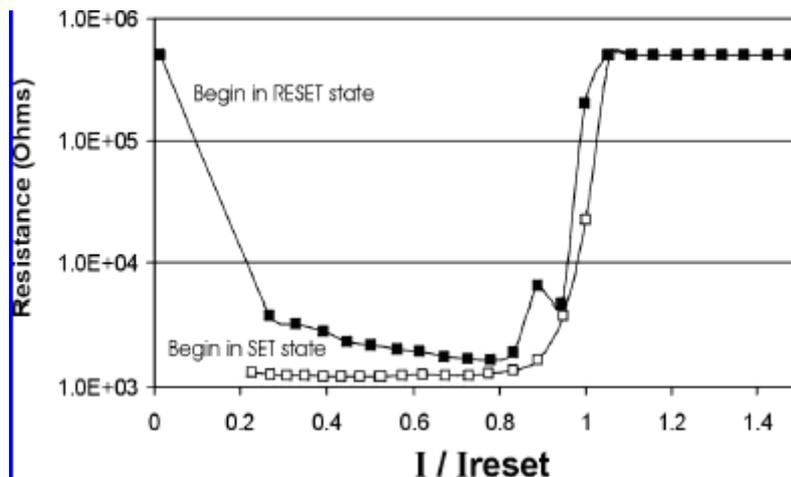


Рис. 2-12. Зависимость сопротивления от величины тока программирования элемента памяти на фазовых переходах.

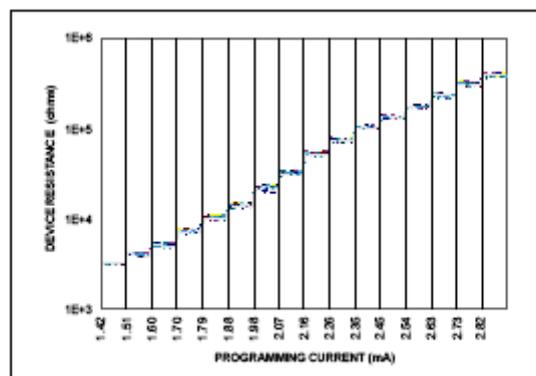


Рис. 2-13. Зависимость сопротивления от величины тока программирования для многоуровневого элемента памяти на фазовых переходах.

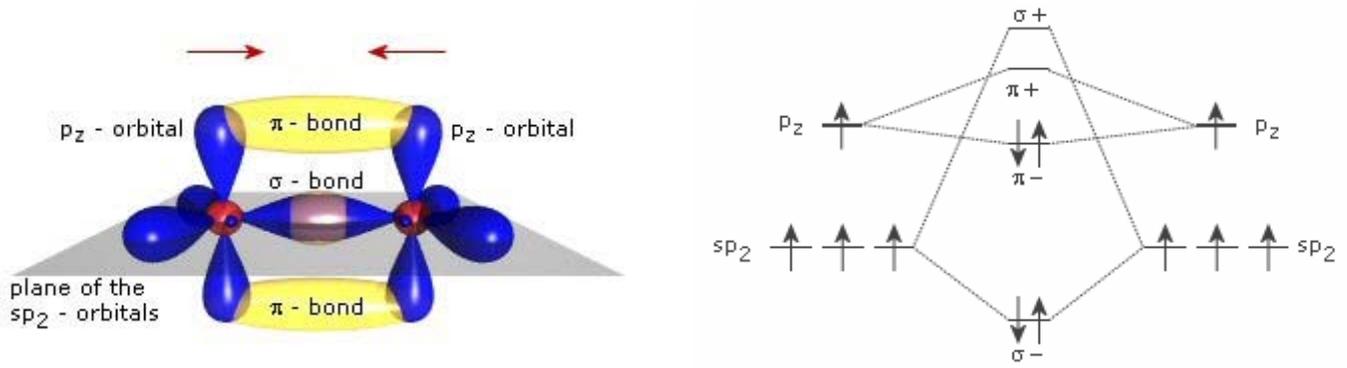


Рис.2-14. Схема орбиталей и связей для двух  $sp^2$  гибридизированных атомов углерода.

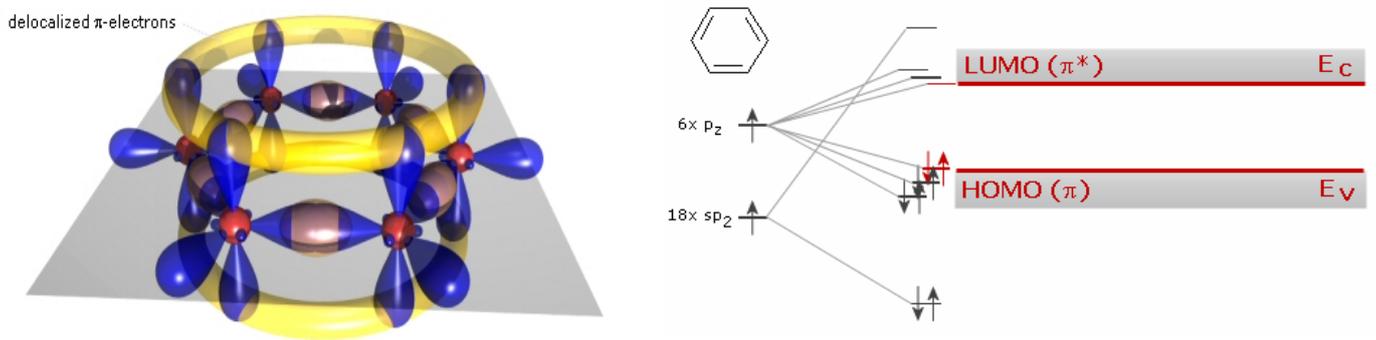


Рис. 2-15. Схема бензольного кольца и энергетической структуры органической молекулы.

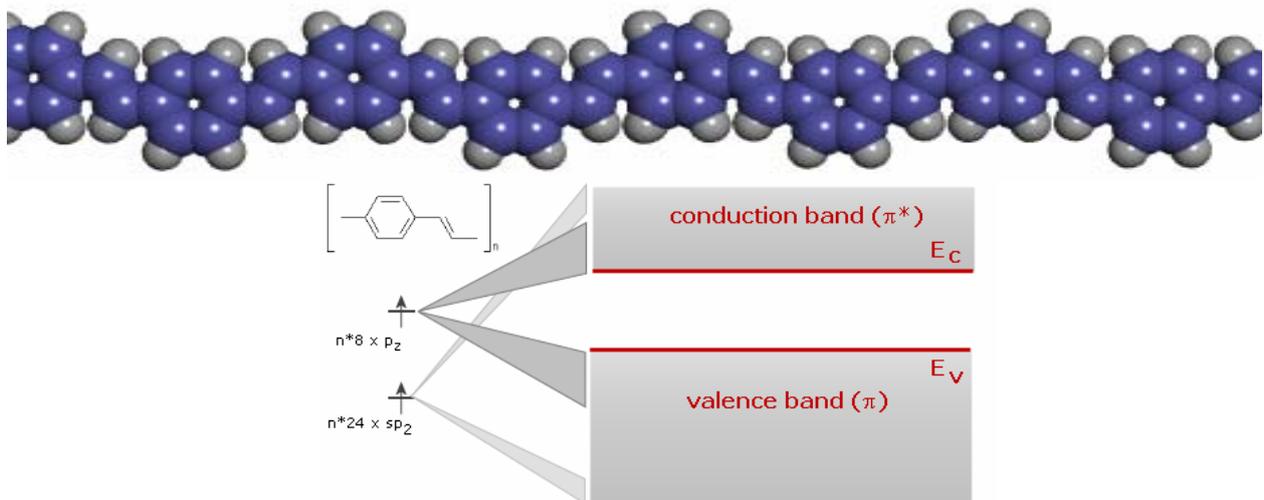


Рис.2-16. Полупроводниковый полимер (poly-p-phenylene-vinylene PPV).

Рис. 2-9. Носители оптической информации.

